

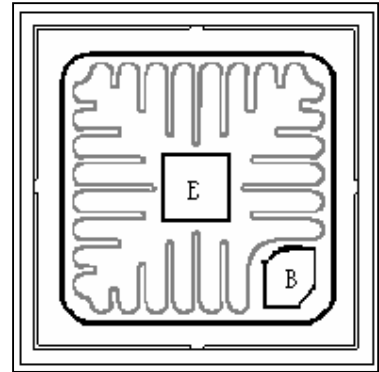


# 882 晶体管芯片说明书

## 芯片简介

芯片尺寸：4 英寸（100mm）  
 芯片代码：C105AJ-00  
 芯片厚度：240±20μm  
 管芯尺寸：1050×1050μm<sup>2</sup>  
 焊位尺寸：B 极 230×230μm<sup>2</sup>；E 极 170×170μm<sup>2</sup>  
 电极金属：铝  
 背面金属：金  
 典型封装：2SD882，HS882，H882

## 芯片图



## 极限值 (T<sub>a</sub>=25 ) (TO-126、TO-126ML)

T<sub>stg</sub>——贮存温度.....-55~150  
 T<sub>j</sub>——结温..... 150  
 P<sub>C</sub>——集电极功率耗散 (T<sub>c</sub>=25 ).....10W  
 P<sub>C</sub>——集电极功率耗散 (T<sub>A</sub>=25 ).....1W  
 V<sub>CB0</sub>——集电极—基极电压.....40V  
 V<sub>CEO</sub>——集电极—发射极电压.....30V  
 V<sub>EBO</sub>——发射极—基极电压 .....5V  
 I<sub>C</sub>——集电极电流 ..... 3A  
 I<sub>B</sub>——基极电流.....0.6A

## 电参数 (T<sub>a</sub>=25 ) (TO-126、TO-126ML)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
I <sub>CB0</sub>	集电极—基极截止电流			1	μA	V <sub>CB</sub> =30V, I <sub>E</sub> =0
I <sub>EBO</sub>	发射极—基极截止电流			1	μA	V <sub>EB</sub> =5V, I <sub>C</sub> =0
h <sub>FE</sub>	直流电流增益	60		400		V <sub>CE</sub> =2V, I <sub>C</sub> =1A
V <sub>CE(sat)</sub>	集电极—发射极饱和压降		0.3	0.5	V	I <sub>C</sub> =2A, I <sub>B</sub> =0.2A
V <sub>BE(sat)</sub>	基极—发射极饱和压降		1.0	2	V	I <sub>C</sub> =2A, I <sub>B</sub> =0.2A
C <sub>ob</sub>	输出电容		45		pF	V <sub>CB</sub> =10V, I <sub>E</sub> =0, f=1MHz
f <sub>T</sub>	特征频率		90		MHz	V <sub>CE</sub> =5V, I <sub>E</sub> =0.1A